

Longsys anuncia sus primeros módulos de memoria DDR5

El fabricante chino Longsys de módulos de DRAM ha anunciado su primer módulo de DDR5, adelantándose a otras compañías al anunciar un modelo concreto con el nombre ES1, aunque más bien habría que hablar de serie.

Estará disponible en algún momento futuro, previsiblemente antes de final de año con los Alder Lake S de Intel, en capacidades de 16 GB y 32 GB.



Estos módulos siguen teniendo 288 pines, pero se mueve la muesca al centro para evitar que se inserten en ranuras para tipos de memoria anteriores. Como los de otras compañías, tienen una velocidad inicial de 4800 MHz con una latencia básica de 40 funcionando a 1.1 V. El tamaño del módulo es de 133.35 mm × 31.25 mm × 1.27 mm y usa una placa de circuito impreso compuesta de ocho capas.

La compañía ha compartido los resultados de algunos test en AIDA64 indicando que tiene hasta un 40 % más de rendimiento aunque en este caso la latencia prácticamente se duplica.

Específicamente sería un 11 % más rápida copiando, 36 % más rápida escribiendo y 40 % más leyendo que la memoria DDR4y CL 22 de la compañía –no veo que se indique la velocidad–.

La DDR5 llega con algunas ventajas adicionales que estarán presentes también en los módulos de Longsys como es el código de corrección de errores (ECC). Es útil no solo para cómputo sino también para evitar errores relacionados con la subida de frecuencia de los mismos, y es una parte integral de la especificación DDR5. Estos módulos se comercializarán fuera de China bajo la marca Lexar, la cual es bastante más conocida –una antigua marca de Micron–.

Fuente: TechPowerUp.